

SF 025*

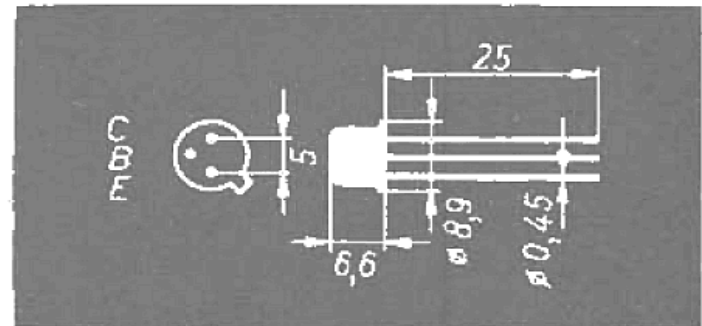
Verwendung: Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker sowie mittelschnelle Schaltstufen

Abmessungen: Bauform B 3/25 - 3a,
TGL 11 811

Kollektor am Gehäuse
Masse \approx 1 g

Zulässige Höchstwerte bis ϑ_{jmax}

$U_{CBO} = 120$ V	$P_{tot} = 600$ mW
$U_{CER} = 120$ V	bei $\vartheta_a = 25$ °C
bei $R_{BE} = 10$ Ω	$P_{tot} = 2,5$ W
$U_{EBO} = 5$ V	bei $\vartheta_c = 25$ °C
$I_C = 500$ mA	$\vartheta_j = +175$ °C
$I_B = 250$ mA	$\vartheta_a = -40$ °C...
$\vartheta_a min = -40$ °C	+150 °C



Wärmewiderstand $R_{thja} \leq 250 \frac{grad}{W}$
 $R_{thjc} \leq 60 \frac{grad}{W}$

Kennwerte für $\vartheta_a = 25$ °C -5 grad

	Min.	Typ	Max.	Meßbedingungen	Stromverstärkungsgruppen
Restströme					
I_{CBO}			100 nA	$U_{CB} = 120$ V	
I_{EBO}			1 μ A	$U_{EB} = 5$ V	
Kollektor-Emitter-Spannung					
U_{CER}		120 V		$I_C = 1$ mA, $R_{BE} = 10$ Ω	
Sättigungsspannung					
U_{CEsat}			1 V	$I_C = 50$ mA, $I_B = 5$ mA	
Übergangsfrequenz					
f_T	60 MHz			$U_{CE} = 10$ V, $I_C = 10$ mA $f = 15$ MHz	
Gleichstromverstärkung					
B	18		35		A
	28		71		B
	56		140		C
	112		280		D
	224		560		E
	450		1120		F

* Nicht für Neuentwicklungen